

MG17100S-BN4MM



Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E71639

Features

- IGBT³ CHIP(1700V Trench+Field Stop technology)
- Low turn-off losses, short tail current
- $V_{CE(sat)}$ with positive temperature coefficient
- DIODE CHIP(1700V EMCON 3 technology)
- Free wheeling diodes with fast and soft reverse recovery

Applications

- High frequency switching application
- Medical applications
- Motion/servo control
- UPS systems

Module Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$T_{J(max)}$	Max. Junction Temperature				150	$^\circ\text{C}$
$T_{J(op)}$	Operating Temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
V_{isol}	Insulation Test Voltage	AC, t=1min		4000		V
CTI	Comparative Tracking Index		350			
Torque	Module-to-Sink	Recommended (M6)	3		5	N·m
Torque	Module Electrodes	Recommended (M5)	2.5		5	N·m
Weight				160		g

Absolute Maximum Ratings ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Values	Unit
IGBT				
V_{CES}	Collector - Emitter Voltage	$T_J=25^\circ\text{C}$	1700	V
V_{GES}	Gate - Emitter Voltage		± 20	V
I_C	DC Collector Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	150	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	100	A
I_{CM}	Repetitive Peak Collector Current	$t_p=1\text{ms}$	200	A
P_{tot}	Power Dissipation Per IGBT		620	W
Diode				
V_{RRM}	Repetitive Reverse Voltage	$T_J=25^\circ\text{C}$	1700	V
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	150	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	100	A
I_{FRM}	Repetitive Peak Forward Current	$t_p=1\text{ms}$	200	A
I^2t		$T_J=125^\circ\text{C}$, $t=10\text{ms}$, $V_R=0\text{V}$	1800	A^2S

Life Support Note:

Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

MG17100S-BN4MM

Power Module

1700V 100A IGBT Module

Electrical and Thermal Specifications ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit	
IGBT							
V _{GE(th)}	Gate - Emitter Threshold Voltage	V _{CE} =V _{GE} , I _C =4.0mA	5.2	5.8	6.4	V	
V _{CE(sat)}	Collector - Emitter Saturation Voltage	I _C =100A, V _{GE} =15V, T _J =25°C		2.0	2.45	V	
		I _C =100A, V _{GE} =15V, T _J =125°C		2.4		V	
I _{CES}	Collector Leakage Current	V _{CE} =1700V, V _{GE} =0V, T _J =25°C			3	mA	
		V _{CE} =1700V, V _{GE} =0V, T _J =125°C			20	mA	
I _{GES}	Gate Leakage Current	V _{CE} =0V, V _{GE} =±20V, T _J =125°C	-400		400	nA	
R _{Gint}	Intergrated Gate Resistor			7.5		Ω	
Q _{ge}	Gate Charge	V _{CE} =900V, I _C =100A , V _{GE} =±15V		1.2		μC	
C _{ies}	Input Capacitance	V _{CE} =25V, V _{GE} =0V, f =1MHz		9		nF	
C _{res}	Reverse Transfer Capacitance			0.29		nF	
t _{d(on)}	Turn - on Delay Time	V _{CC} =900V I _C =100A R _G =4Ω V _{GE} =±15V Inductive Load	T _J =25°C		370		ns
			T _J =125°C		400		ns
t _r	Rise Time		T _J =25°C		40		ns
			T _J =125°C		50		ns
t _{d(off)}	Turn - off Delay Time		T _J =25°C		650		ns
			T _J =125°C		800		ns
t _f	Fall Time		T _J =25°C		180		ns
			T _J =125°C		300		ns
E _{on}	Turn - on Energy		T _J =25°C		22		mJ
			T _J =125°C		32		mJ
E _{off}	Turn - off Energy		T _J =25°C		21.5		mJ
			T _J =125°C		32.5		mJ
I _{SC}	Short Circuit Current	t _{psc} ≤10μS , V _{GE} =15V; T _J =125°C, V _{CC} =1000V		400		A	
R _{thJC}	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per IGBT)				0.20	K/W	
Diode							
V _F	Forward Voltage	I _F =100A , V _{GE} =0V, T _J =25°C		1.8	2.2	V	
		I _F =100A , V _{GE} =0V, T _J =125°C		1.9		V	
I _{RRM}	Max. Reverse Recovery Current	I _F =100A , V _R =900V di _F /dt=-2450A/μs T _J =125°C		165		A	
Q _{rr}	Reverse Recovery Charge			48.5		μC	
E _{rec}	Reverse Recovery Energy			27.5		mJ	
R _{thJCD}	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per Diode)				0.36	K/W	

Figure 1: Typical Output Characteristics

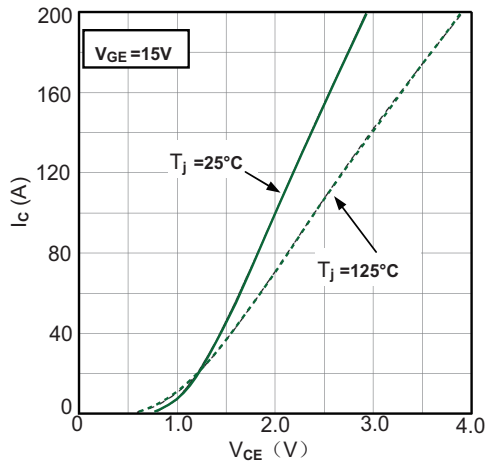


Figure 2: Typical Output Characteristics

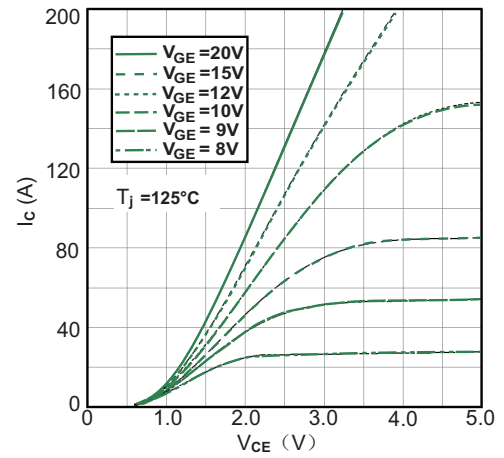


Figure 3: Typical Transfer characteristics

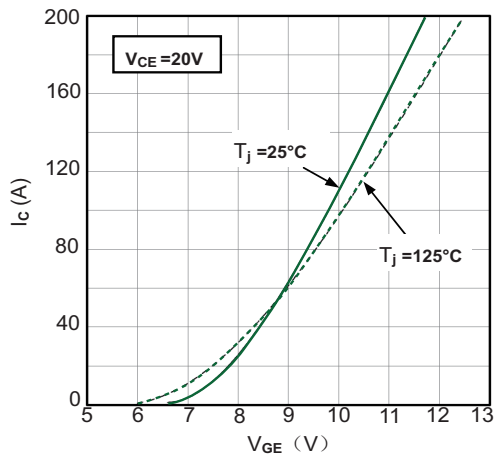


Figure 4: Switching Energy vs. Gate Resistor

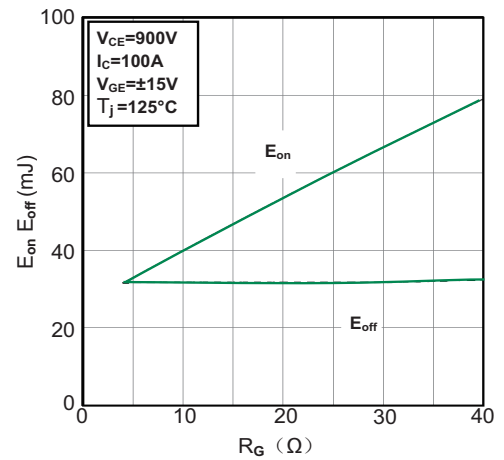


Figure 5: Switching Energy vs. Collector Current

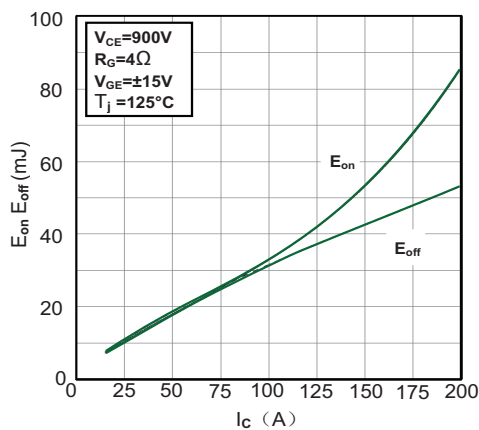


Figure 6: Reverse Biased Safe Operating Area

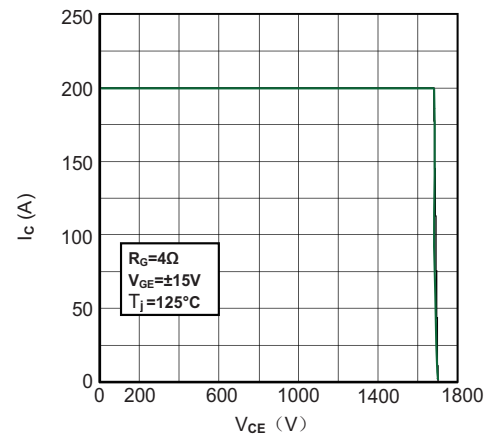


Figure 7: Diode Forward Characteristics

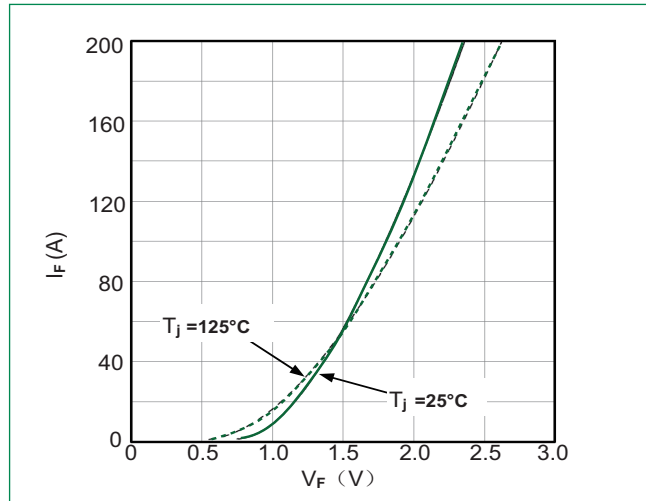


Figure 8: Switching Energy vs. Gate Resistor

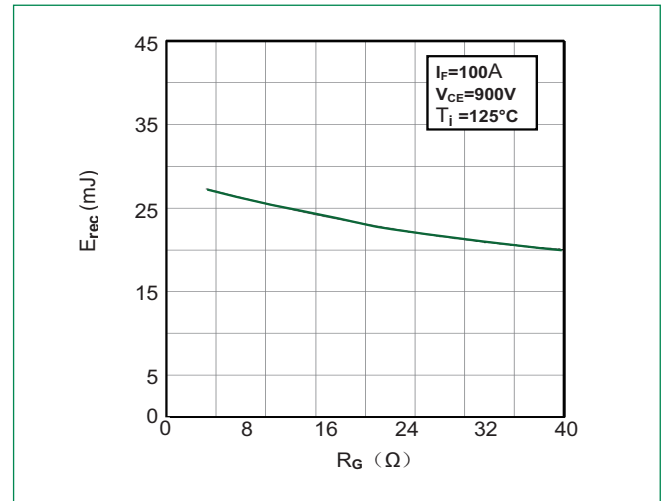


Figure 9: Switching Energy vs. Forward Current

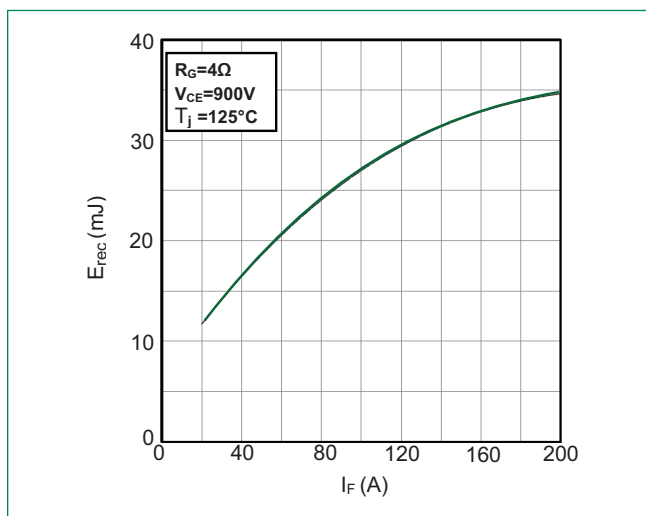
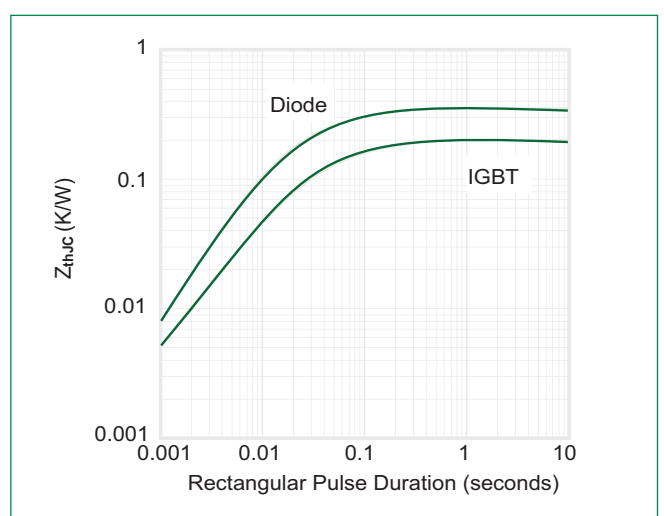
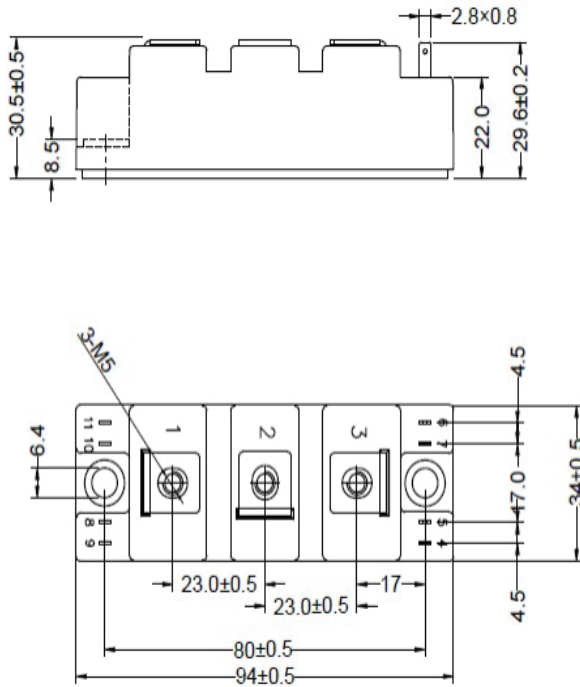


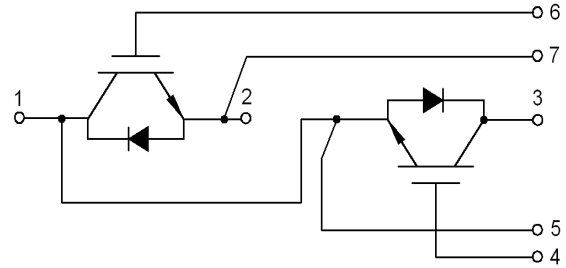
Figure 10: Transient Thermal Impedance of Diode and IGBT



Dimensions-Package S



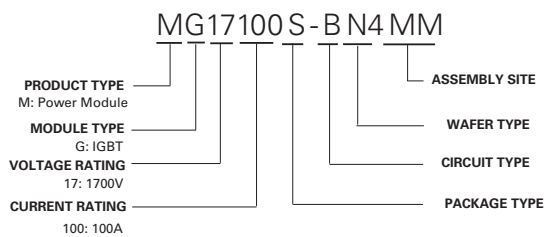
Circuit Diagram



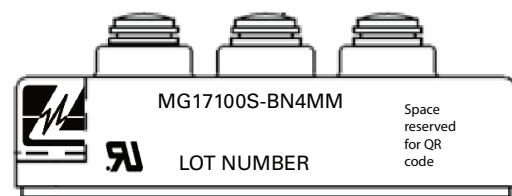
Packing Options

Part Number	Marking	Weight	Packing Mode	M.O.Q
MG17100S-BN4MM	MG17100S-BN4MM	160g	Bulk Pack	50

Part Numbering System



Part Marking System



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А